



# IR Emitter and Detector Product Data Sheet

LTE-306

Spec No.: DS-50-92-0115

Effective Date: 06/19/2007

Revision: D

**LITE-ON DCC**

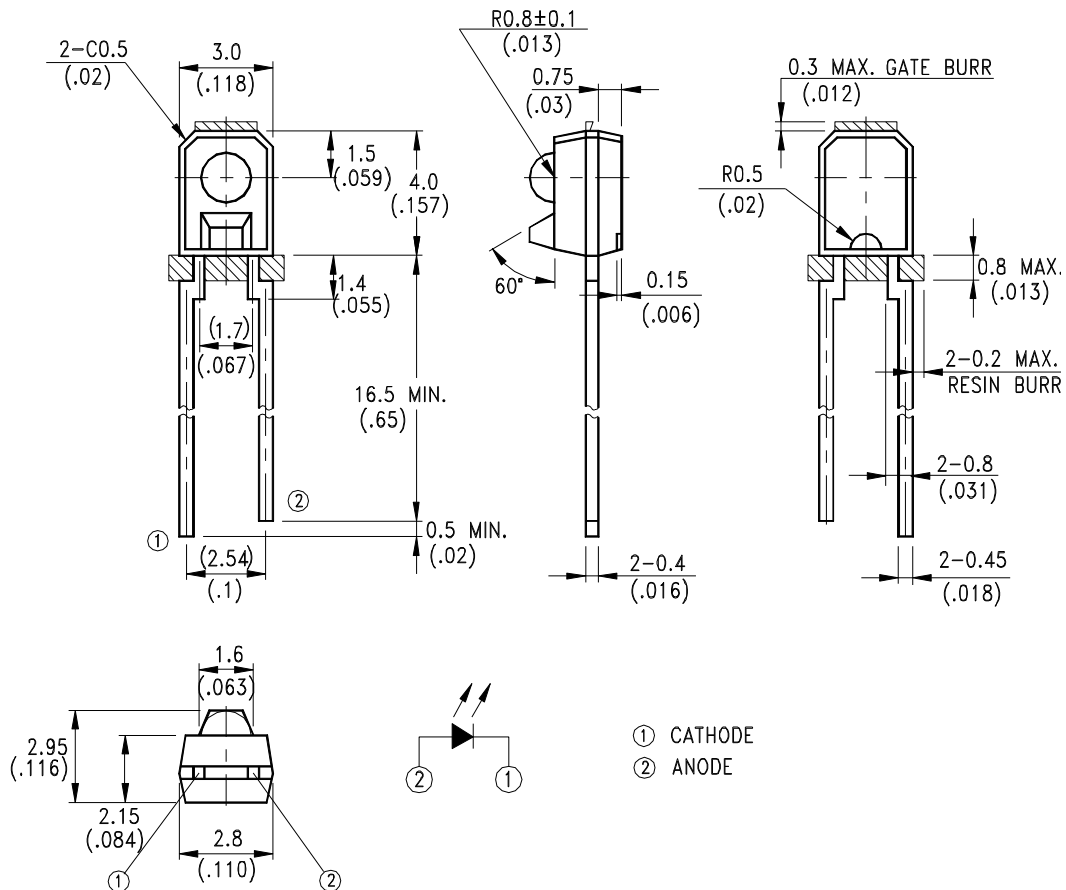
**RELEASE**

BNS-OD-FC001/A4

## FEATURES

- \* SELECTED TO SPECIFIC ON-LINE INTENSITY AND RADIANT INTENSITY RANGES
- \* LOW COST MINIATURE PLASTIC SIDE LOOKING PACKAGE
- \* MECHANICALLY AND SPECTRALLY MATCHED TO THE LTR-306 SERIES OF PHOTOTRANSISTOR

## PACKAGE DIMENSIONS



## NOTES:

1. All dimensions are in millimeters (inches).
2. Tolerance is  $\pm 0.25\text{mm}(.010\text{'})$  unless otherwise noted.
3. Lead spacing is measured where the leads emerge from the package.
4. Specifications are subject to change without notice.



**ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS AT TA=25°C**

PARAMETER	MAXIMUM RATING	UNIT
Power Dissipation	75	mW
Peak Forward Current (300pps, 10 $\mu$ s pulse)	1	A
Continuous Forward Current	50	mA
Reverse Voltage	5	V
Operating Temperature Range	-40°C to + 85°C	
Storage Temperature Range	-55°C to + 100°C	
Lead Soldering Temperature [1.6mm(.063") From Body]	260°C for 5 Seconds	

## ELECTRICAL OPTICAL CHARACTERISTICS AT TA=25°C

PARAMETER	SYMBOL	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT	TEST CONDITION	BIN NO.
Aperture Radiant Incidence	E <sub>e</sub>	0.088		0.168	mW/cm <sup>2</sup>	I <sub>F</sub> = 20mA	BIN A
		0.112		0.204			BIN B
		0.136		0.240			BIN C
		0.160		0.300			BIN D
		0.200		0.360			BIN E
		0.240		0.420			BIN F
		0.280		0.480			BIN G
		0.320					BIN H
Radiant Intensity	I <sub>E</sub>	0.662		1.263	mW/sr	I <sub>F</sub> = 20mA	BIN A
		0.842		1.534			BIN B
		1.023		1.805			BIN C
		1.203		2.256			BIN D
		1.504		2.707			BIN E
		1.805		3.158			BIN F
		2.105		3.609			BIN G
		2.403					BIN H
Peak Emission Wavelength	λ <sub>Peak</sub>		940		nm	I <sub>F</sub> = 20mA	
Spectral Line Half-Width	Δλ		50		nm	I <sub>F</sub> = 20mA	
Forward Voltage	V <sub>F</sub>		1.2	1.6	V	I <sub>F</sub> = 20mA	
Reverse Current	I <sub>R</sub>			100	μA	V <sub>R</sub> = 5V	
Viewing Angle (See FIG.6)	2θ <sub>1/2</sub>		30		deg.		

## TYPICAL ELECTRICAL / OPTICAL CHARACTERISTICS CURVES

(25°C Ambient Temperature Unless Otherwise Noted)

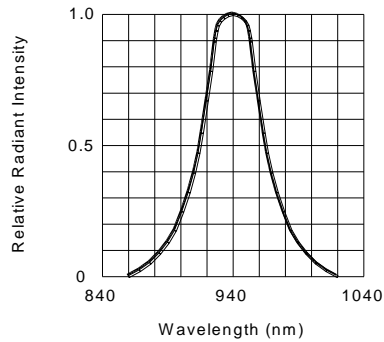


FIG.1 SPECTRAL DISTRIBUTION

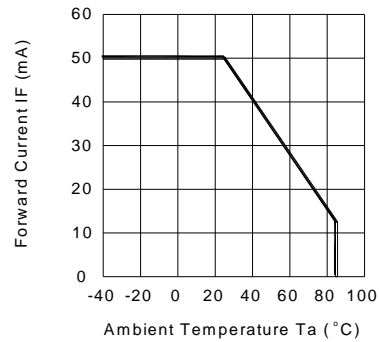


FIG.2 FORWARD CURRENT VS. AMBIENT TEMPERATURE

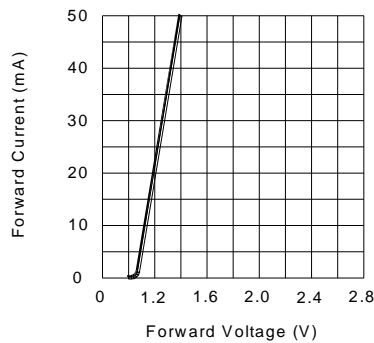


FIG.3 FORWARD CURRENT VS. FORWARD VOLTAGE

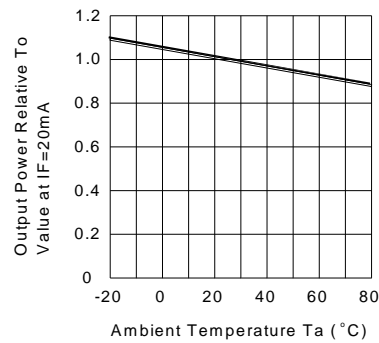


FIG.4 RELATIVE RADIANT INTENSITY VS. AMBIENT TEMPERATURE

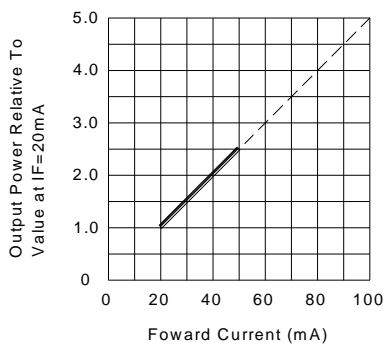


FIG.5 RELATIVE RADIANT INTENSITY VS. FORWARD CURRENT

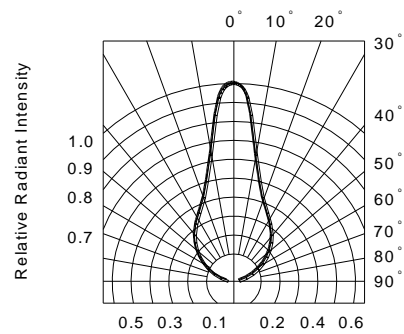


FIG.6 RADIATION DIAGRAM

# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Lite-On:](#)

[LTE-306](#)

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9